

МАТРИЦА РЕЗИСТОРОВ**500HP400****Назначение выводов**

1 — свободный	9 — свободный
2 — вход 800 Ом	10 — вход 500 Ом
3 — вход 800 Ом	11 — свободный
4 — свободный	12 — вход 500 Ом
5 — вход 500 Ом	13 — свободный
6 — свободный	14 — вход 800 Ом
7 — вход 500 Ом	15 — вход 800 Ом
8 — минус 5,2 В	16 — общий

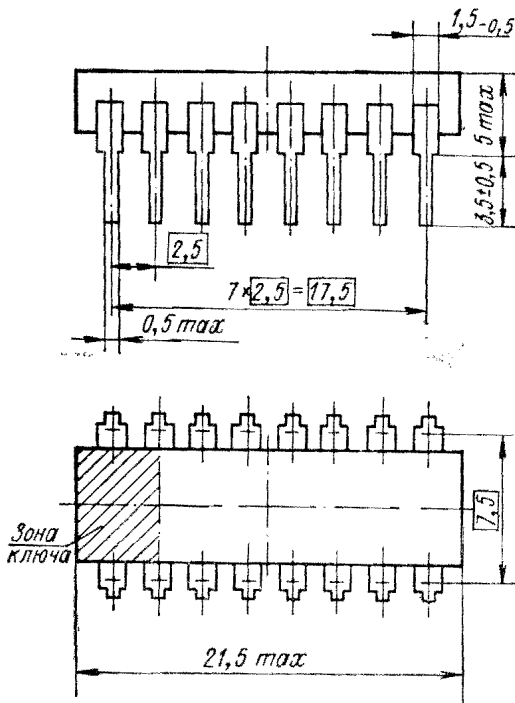
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	минус $5,2 \pm 5\%$
Сопротивление резисторов R_2, R_3, R_5, R_7, R_8 , Ом	от 425 до 575

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 500

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 238.16-2)



Масса не более 1,2 г

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 500

Общие данные

Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	5 (665)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхем 500PУ410, 500РЕ149	70
» остальных микросхем	75
Пониженная температура среды, °С	минус 10
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхем 500PУ410, 500РЕ149	от минус 10
	до +70
» остальных микросхем	от минус 60
	до +75

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ч	50 000
Срок сохраняемости лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Кристаллы, предназначенные для последующей обработки микросхем, поставляются по настоящим техническим условиям, по нормам технологического контроля «цеховая для кристалла в пластине».

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лакокрасочным покрытием в 3 слоя. Рекомендуемое покрытие — лак УР-231 по ТУ 6-10-863—84.

○ В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 500

Общие данные

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов и напряжения питания к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной электрической схеме, а также соединённые этих выводов с корпусом аппаратуры.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:

минимальное входное напряжение	минус 2
максимальное входное напряжение	минус 0,75
Максимальный выходной ток, мА	32
	27 *
Максимальная температура кристалла, °С	125

* Для микросхем 500РУ415, 500РУ410.